

# 2SD1076, 2SD1076L

シリコン NPN エピタキシャル LTP 形

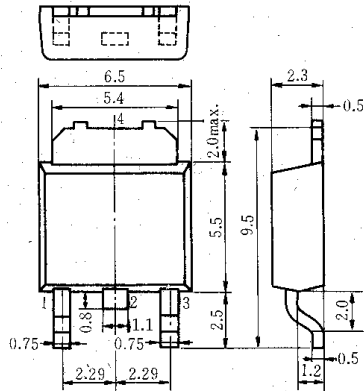
低周波電力増幅用

2SB836, 2SB836L とコンプリメンタリペア

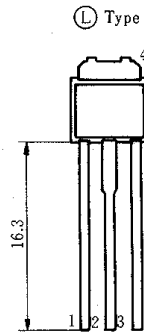
SILICON NPN EPITAXIAL LTP

LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER

Complementary pair with 2SB836 and 2SB836L



(DPAK)



- ① Type
1. ベース: Base
  2. コレクタ: Collector
  3. エミッタ: Emitter
  4. コレクタ: Collector
- (Dimensions in mm)

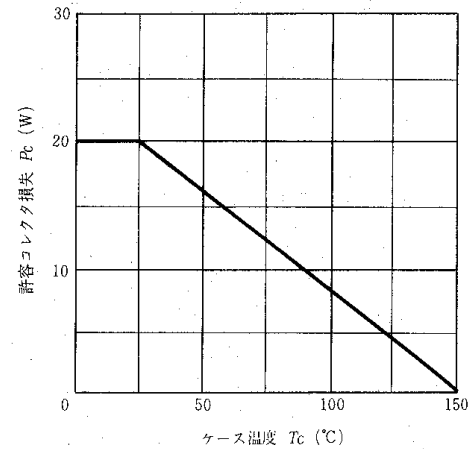
## ■絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

項目	Symbol	2SD1076/①	Unit
コレクタ・ベース電圧	$V_{CB0}$	25	V
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CE0}$	25	V
エミッタ・ベース電圧	$V_{EB0}$	5	V
コレクタ電流	$I_C$	2.5	A
せん頭コレクタ電流	$i_{C(peak)}$	3	A
許容コレクタ損失	$P_C^*$	20	W
接合部温度	$T_j$	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	$T_{stg}$	-55~+150	$^\circ\text{C}$

\*  $T_c=25^\circ\text{C}$  における許容値

\* Value at  $T_c=25^\circ\text{C}$

## 許容コレクタ損失のケース温度による変化 MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



## ■電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

項目	Symbol	Test Condition	min	typ	max	Unit
コレクタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)CBO}$	$I_C=1\text{mA}, I_E=0$	25	—	—	V
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=10\text{mA}, R_{BE}=\infty$	25	—	—	V
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=1\text{mA}, I_C=0$	5	—	—	V
コレクタ遮断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB}=25\text{V}, I_E=0$	—	—	20	$\mu\text{A}$
直流電流増幅率	$h_{FE}$	$V_{CE}=2\text{V}, I_C=1.5\text{A}^*$	20	—	—	
ベース・エミッタ電圧	$V_{BE}$	$V_{CE}=2\text{V}, I_C=1.5\text{A}$	—	0.93	1.5	V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=2\text{A}, I_B=0.2\text{A}$	—	0.5	1.0	V

\*パルス測定

\* Pulse Test